Fast Recovery Diode

D3FK60

600V 2.1A

特 長

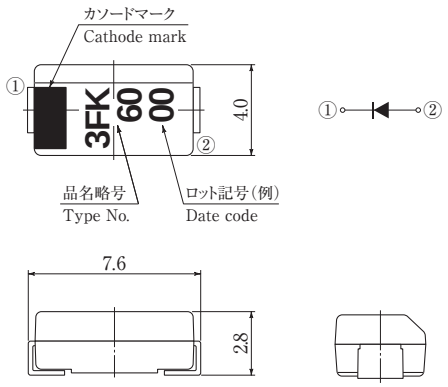
- 小型SMD
- 高耐圧
- trr＝100ns
- 低V_F

Feature

- Small SMD
- High Voltage
- trr=100ns
- Low V_F

■外観図　OUTLINE

Package：2F　　Unit：mm



外形図については新電元Webサイトをご参照下さい。捺印表示については捺印仕様をご確認下さい。
For details of the outline dimensions, refer to our web site. As for the marking, refer to the specification "Marking, Terminal Connection".

■定格表　RATINGS

●絶対最大定格　Absolute Maximum Ratings（指定のない場合　Tl＝25℃）

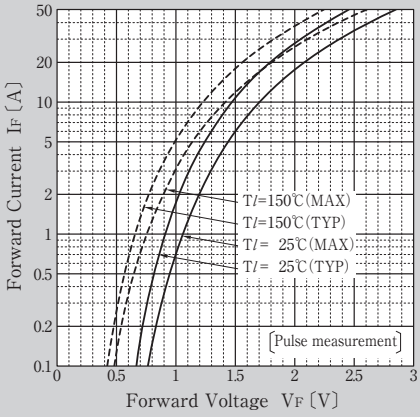
項　目 Item	記号 Symbol	条　件 Conditions	規格値 Ratings	単位 Unit
保存温度 Storage Temperature	Tstg		−55〜150	℃
接合部温度 Operation Junction Temperature	Tj		150	℃
せん頭逆電圧 Maximum Reverse Voltage	V_{RM}		600	V
出力電流 Average Rectified Forward Current	Io	50Hz正弦波，抵抗負荷，プリント基板実装　Ta＝25℃ 50Hz sine wave, Resistance load, glass-epoxy substrate Ta＝25℃	1.1	A
		50Hz正弦波，抵抗負荷，アルミナ基板実装　Ta＝25℃ 50Hz sine wave, Resistance load, alumina substrate Ta＝25℃	1.5	
		50Hz正弦波，抵抗負荷，Tl＝93℃ 50Hz sine wave, Resistance load, Tl＝93℃	2.1	
せん頭サージ順電流 Peak Surge Forward Current	I_{FSM}	50Hz正弦波，非繰り返し1サイクルせん頭値，Tj＝25℃ 50Hz sine wave, Non-repetitive 1 cycle peak value, Tj=25℃	120	A
電流二乗時間積 Current Squared Time	I^2t	1ms≦t＜10ms，Tj＝25℃	72	A^2s

●電気的・熱的特性　Electrical Characteristics（指定のない場合　Tl＝25℃）

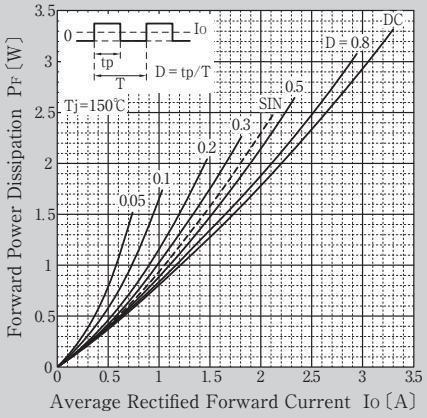
順電圧 Forward Voltage	V_F	I_F＝2.1A，　パルス測定 Pulse measurement	MAX 1.2	V
逆電流 Reverse Current	I_R	V_R＝600V，　パルス測定 Pulse measurement	MAX 10	μA
逆回復時間 Reverse Recovery Time	trr	I_F＝0.5A, I_R＝1A, 0.25I_R	MAX 100	ns
接合容量 Junction Capacitance	Cj	f＝1MHz, V_R＝10V	TYP 37	pF
熱抵抗 Thermal Resistance	θjl	接合部・リード間 Junction to lead	MAX 23	℃/W
	θja	接合部・周囲間，アルミナ基板実装 Junction to ambient, alumina substrate	MAX 80	
		接合部・周囲間，プリント基板実装 Junction to ambient, glass-epoxy substrate	MAX 115	

■特性図　CHARACTERISTIC DIAGRAMS

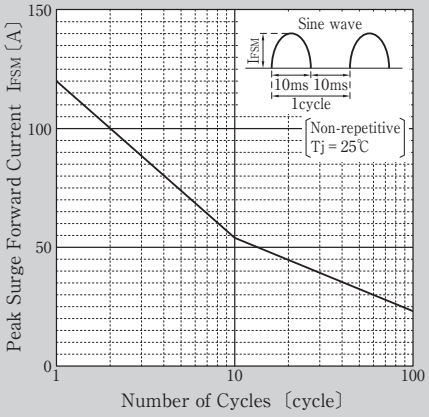
順方向特性
Forward Voltage



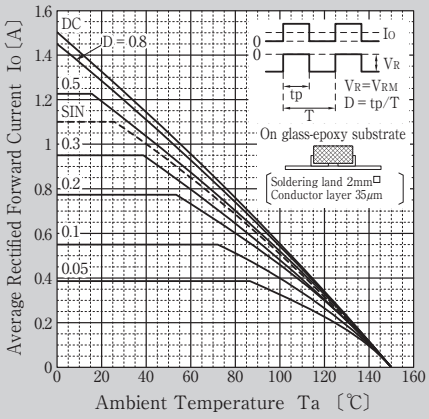
順電力損失曲線
Forward Power Dissipation



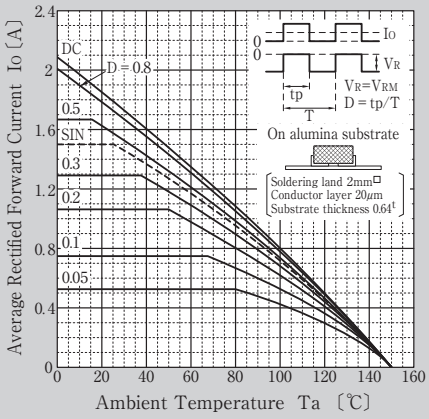
せん頭サージ順電流耐量
Peak Surge Forward Current Capability



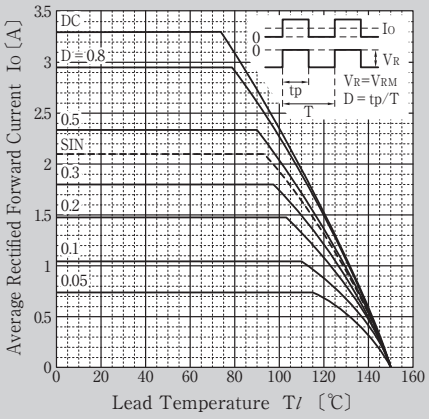
ディレーティングカーブ Ta-Io
Derating Curve Ta-Io



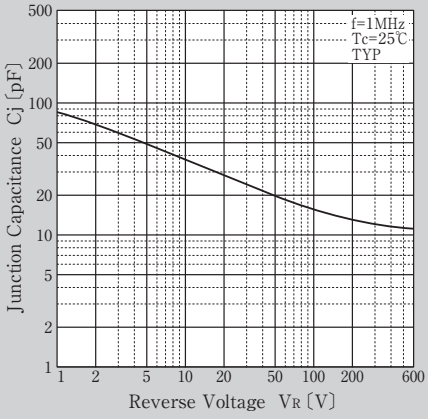
ディレーティングカーブ Ta-Io
Derating Curve Ta-Io



ディレーティングカーブ Tl-Io
Derating Curve Tl-Io



接合容量
Junction Capacitance



＊Sine waveは50Hzで測定しています。
＊50Hz sine wave is used for measurements.